



3DO
3DO

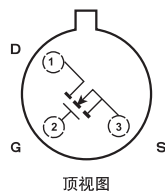
3DO6 3DO26

3DO 系列MOS场效应管

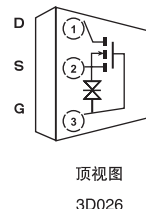
N沟道增强型

- 输入阻抗 $> 10^9 \Omega$
- 导通电阻 $< 300 \Omega$
- 关断电阻 $\geq 10^7 \Omega$

TO-206AA(TO-18)



TO-92s



- 传输开关电路
- 阻抗变换电路
- 信号放大器
- 斩波器
- 压控振荡器

参数	档级	A	B
$V_{GS}(TO)$		2.5 ~ 5	0.5 ~ 3

参数名称	符号	数值	单位
最大漏极电流	I_D	15	mA
最大耗散功率	P_D	100	mW
最高有效结温	T_j	175	$^{\circ}C$
最低和最高工作环境温度	T_{stg}	-55 ~ 125	$^{\circ}C$
最低和最高贮存温度	T_{amb}	-55 ~ 175	$^{\circ}C$

测试参数和条件	参数名称	3DO6 3DO26		单位
		MIN	MAX	
栅源击穿电压 $V_{DS}=0V, I_G=-1\mu A$	$V_{(BR)GSS}$	-25		V
栅源截止电流 $V_{DS}=0V, V_{GS}=10V$	I_{GSS}		10	nA
栅源阈值电压 $V_{DS}=10V, I_{DS}=10\mu A$	$V_{GS}(TO)$	0.5	5	V
小信号短路正向跨导 $V_{DS}=10V, I_{DS}=3mA, f=1kHz$	g_{fs}	2000		μS
通态电阻 $V_{GS}=10V, I_{DS}=1mA$	$r_{DS(on)}$		300	Ω
关态电阻 $V_{DS}=10V, V_{GS}=0V$	$r_{DS(off)}$	10^7		Ω
小信号短路输入电容 $V_{DS}=10V, V_{GS}=0V, f=500KHz$	C_{iss}		3	pF
小信号短路反馈电容 $V_{DS}=10V, V_{GS}=0V, f=500KHz$	C_{rss}		0.8	pF